

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-262489

(43)Date of publication of application : 11.10.1996

(51)Int.Cl.

G02F 1/136
H01L 21/3065
H01L 29/786

(21)Application number : 07-066296

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 24.03.1995

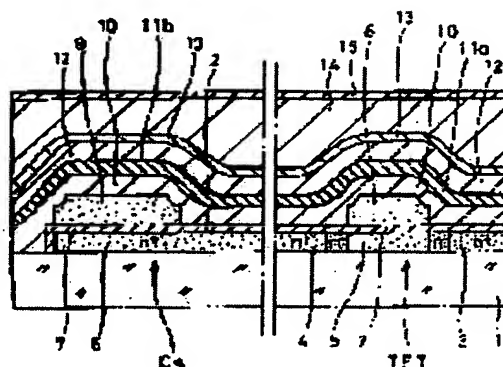
(72)Inventor : NAGAKARI YASUTAKA
OKAMOTO KAZUHIRO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the yield of a semiconductor device by enabling fine working of ground surface patterns, such as electrode patterns, and preventing the disconnection of wiring layers formed atop these patterns.

CONSTITUTION: An active layer 2 by a first layer of polycrystalline silicon layer is formed on a quartz substrate 1 and one-side electrodes 6 of signal storage capacitors Cs are formed by introducing an impurity of n-type into this active layer 2. A second layer of the polycrystalline silicon layer is thereafter formed on the active layer 2 via a thermal oxidized film (a gate insulation film) 7. The polycrystalline silicon layers are selectively removed by isotropic etching down to the middle in their thickness direction. The remaining polycrystalline silicon layers are thereafter selectively removed by anisotropic etching, by which the gate electrodes 8 of the TFTs and another electrodes 9 of the signal storage capacitors Cs by the polycrystalline silicon layers are formed. In such a case, the corner parts of the upper parts of the respective electrodes 8 and 9 have the shape chamfered by side etching of the isotropic etching.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 24.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 12.03.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-262489

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

(51)Int.Cl.*	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 2 F 1/136	5 0 0		G 0 2 F 1/136	5 0 0
H 0 1 L 21/3065			H 0 1 L 21/302	J
29/786			29/78	6 1 7 K

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 10 頁)

(21)出願番号 特願平7-66296

(22)出願日 平成7年(1995)3月24日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 永俣 靖貴

鹿児島県国分市野口北5-1 ソニー国分株式会社内

(72)発明者 岡元 和裕

鹿児島県国分市野口北5-1 ソニー国分株式会社内

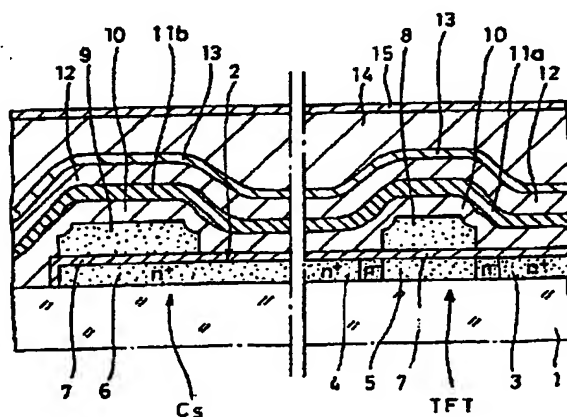
(74)代理人 弁理士 松隈 秀盛

(54)【発明の名称】 半導体装置及び半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 電極パターン等の下地パターンの微細加工を可能とし、かつその上面に形成される配線層の断線を防止して、半導体装置の歩留まりの向上を図る。

【構成】 石英基板1上に1層目の多結晶シリコン層による活性層2を形成し、該活性層2に対してn形の不純物を導入して信号蓄積キャパシタCsの一方の電極6を形成する。その後、活性層2上に熱酸化膜(ゲート絶縁膜)7を介して2層目の多結晶シリコン層を形成し、該多結晶シリコン層をその厚み方向途中まで、等方性エッチングにて選択的に除去する。その後、残りの多結晶シリコン層を異方性エッチングにて選択的に除去して該多結晶シリコン層によるTFTのゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9を形成する。この場合、各電極8及び9の上部の角部は等方性エッチングのサイドエッチングにより面取りされた形状となる。



- | | |
|---------------|---------------------|
| 1... 石英基板 | 8... ゲート電極 |
| 2... 活性層 | 9... Csの他方の電極 |
| 3... ソース領域 | 10, 12... 層間絶縁層 |
| 4... ドレイン領域 | 11a, 11b... 信号線、配線線 |
| 6... Csの一方の電極 | |
| 7... ゲート絶縁膜 | |

本実施例の構成を示す断面図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下地パターンを含む2層以上の積層膜の少なくとも上記下地パターンの角部が面取りされていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 上記下地パターンが、不純物導入により導電化された半導体層による電極であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 上記下地パターンが、液晶駆動用TFTにおけるゲート電極と信号蓄積キャパシタ電極であることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項4】 下地パターンを含む2層以上の積層膜を有する半導体装置の製造方法において、上記下地パターンとなる膜を形成する工程と、上記膜の上部を等方性エッチングにて選択的に除去する工程と、

上記膜を異方性エッチングにて選択的に除去して上記下地パターンを形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項5】 上記下地パターンが、液晶駆動用TFTにおけるゲート電極と信号蓄積キャパシタ電極であることを特徴とする請求項4記載の半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関し、例えば、アクティブマトリクス表示方式における液晶表示装置の液晶用駆動スイッチとして使用されるTFT（薄膜トランジスタ）に用いて好適な半導体装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】一般に、テレビなど精細な画像を表示する場合には、解像度の高い映像が求められるため、キャラクタディスプレイ等比べてより精細なマトリクスの構成が必要になる。従来の単純マトリクス表示方式の場合、マトリクスの構成を精細にするほど、走査電極や表示電極の数が増え、それに伴って、液晶の応答速度が遅くなり、クロストークによる弊害が生じる。

【0003】そこで、最近では、スイッチング素子をマトリクス状に配列したアレイを用いて、液晶を直接スイッチ駆動するいわゆるアクティブマトリクス表示方式が注目され、実用化に至っている。この表示方式では、クロストークの問題がなく、しかも、最近めざましく進歩したLSI製造技術を駆使することによって、非常に精細な画像が表示できる液晶テレビなどを容易に実現させることができる。

【0004】従来のアクティブマトリクス表示方式の液晶表示装置の製造方法を図6及び図7に基づいて説明すると、まず、図6Aに示すように、石英基板101上に多結晶シリコン層を例えばCVD法にて形成した後、該多結晶シリコン層をパターンニングして多結晶シリコン層による活性層102を形成する。

【0005】次に、図6Bに示すように、熱酸化を施して活性層102の全面に熱酸化膜103を形成する。この熱酸化膜103は、その後に形成されるTFTのゲート絶縁膜及び信号蓄積キャパシタの絶縁膜となる。その後、信号蓄積キャパシタとなる部分にn形の不純物（例えば砒素（As））を導入して信号蓄積キャパシタの一方の電極104を形成する。

【0006】次に、図6Cに示すように、全面に2層目の多結晶シリコン層を形成した後、該多結晶シリコン層をパターンニングして、多結晶シリコン層によるゲート電極105及び信号蓄積キャパシタ電極106を形成する。その後、ゲート電極105をマスクとして活性層102にn形の不純物（例えば砒素（As））をイオン注入してソース領域107及びドレイン領域108を形成する。

【0007】次に、図6Dに示すように、全面に上層の配線との短絡防止のための膜厚の厚い例えばSiO₂等からなる1層目の層間絶縁膜109を例えばCVD法にて形成する。

【0008】次に、図7Aに示すように、全面に配線材料である例えばAl層を例えばスパッタリングにて被着形成した後、該Al層をパターンニングしてAl層による信号線110を形成する。

【0009】次に、図7Bに示すように、全面に上層の電極との短絡防止のための膜厚の厚い例えばSiO₂等からなる2層目の層間絶縁膜111を例えばCVD法にて形成する。その後、TFTの性能向上用に薄膜のSiN膜112を例えばプラズマCVD法にて形成する。

【0010】次に、図7Cに示すように、全面に表面の凹凸を無くすための例えばSOG等からなる平坦化膜113を形成する。その後、ITO膜を例えばスパッタリングにて被着形成した後、該ITO膜をパターンニングして液晶表示用の透明電極114を形成する。この透明電極114は、各絵素毎に分離されたかたちとなる。

【0011】その後の工程は、図示を省略するが、上記石英基板101と別の石英基板（一主面に対向電極が形成されている）をそれぞれ透明電極114と対向電極とが向かい合うように対向させ、かつスペーサを介して封着し、更に石英基板101と上記別の石英基板間に液晶層を注入した後、その注入口を封止して液晶表示装置を得る。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】ところで、電極材料である例えば多結晶シリコン層をパターンニングするためのドライエッチングとして、図8Aに示すように、全ての方向にエッチングが進む等方性エッチングによる方法と、図8Bに示すように、1方向のみエッチング進む異方性エッチングによる方法がある。

【0013】等方性エッチングの場合、図8Aに示すように、フォトリジスト121下の多結晶シリコン層12

2に対するサイドエッチングが進むため、多結晶シリコン層122をフォトリソ121のレジストパターンに沿った形状にパターニングを行なうことができないが、異方性エッチングの場合、図8Bに示すように、多結晶シリコン層122をフォトリソ121のレジストパターンに沿った形状にパターニングを行なうことができることから、線幅の微細化が進むに伴い、上記異方性エッチングによる方法が必要な技術となってくる。

【0014】そして、パターン形成された膜上にある種の膜をCVDにて被着形成した際、水平方向に比べて垂直方向の膜厚が薄くなる傾向がある。即ち、図9の例で示すと、パターン形成された例えば多結晶シリコン層による電極パターン122上にある膜123をCVD法等で被着形成した場合、電極パターン122上面における膜厚 t_1 よりも段差側面における膜厚 t_2 が薄くなる傾向がある($t_1 > t_2$)。

【0015】この傾向は、パターン形成された膜(例えば多結晶シリコン層による電極パターン122など)の段差が高くなるほど顕著に現れることになる。

【0016】そのため、図7Aで示すように、A1層をスパッタリングにて被着形成した後に、該A1層をパターニングして信号線110を形成した際、A1層が下層の段差部分で断線するおそれがあった。

【0017】本発明は、上記の課題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、例えば電極パターン等の下地パターンの上面に形成される配線層の断線を防止することができる半導体装置を提供することにある。

【0018】また、本発明の他の目的は、例えば電極パターン等の下地パターンの微細加工が可能で、かつその上面に形成される配線層の断線を防止することができ、半導体装置の歩留まりの向上を図ることができる半導体装置の製造方法を提供することにある。

【0019】

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置は、下地パターンを含む2層以上の積層膜の少なくとも上記下地パターンの角部を面取りして構成する。

【0020】また、本発明の半導体装置の製造方法は、下地パターンを含む2層以上の積層膜を有する半導体装置の製造方法において、上記下地パターンとなる膜を形成する工程と、上記膜の上部を等方性エッチングにて選択的に除去する工程と、上記膜を異方性エッチングにて選択的に除去して上記下地パターンを形成する工程とを有する。

【0021】

【作用】本発明に係る半導体装置においては、下地パターンの角部が面取りされていることから、該下地パターン上に形成される膜の特に下地パターンの段差部に対応する部分がなだらかとなって、上記膜形成後において、上記下地パターンの段差が小さくなり、しかも、該膜のステップカバレッジ(段差被覆性)が良好となる。

【0022】その結果、下地パターン上に形成された膜上に形成される例えば配線層の断切れが回避され、下地パターン上に積層膜が形成された半導体装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0023】特に、下地パターンが液晶駆動用TFTにおけるゲート電極と信号蓄積キャパシタ電極である場合、上層に形成される配線材料である例えばA1層(信号線)の断切れが回避され、液晶駆動用TFTを有する液晶表示装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0024】次に、本発明の半導体装置の製造方法においては、下地パターンとなる膜を形成した後、該膜の上部を等方性エッチングにて選択的に除去する。このとき、等方性エッチングの特性により、膜のサイドエッチングが進み、そのエッチング段差がなめらかとなる。その後、上記膜を異方性エッチングにて選択的に除去して上記膜による下地パターンを形成する。

【0025】下地パターンは、最初の等方性エッチングによって、そのエッチング段差がなめらかとされているため、異方性エッチング後の下地パターンの角部が面取りされたかたちとなる。

【0026】従って、下地パターン上に形成される膜の特に下地パターンの段差部に対応する部分がなだらかとなって、上記膜形成後において、上記下地パターンの段差が小さくなり、しかも、該膜のステップカバレッジ(段差被覆性)が良好となる。

【0027】その結果、下地パターン上に形成された上記膜上に形成される例えば配線層の断切れが回避され、下地パターン上に積層膜が形成された半導体装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0028】特に、下地パターンが液晶駆動用TFTにおけるゲート電極と信号蓄積キャパシタ電極である場合、上層に形成される配線材料である例えばA1層(信号線)の断切れが回避され、液晶駆動用TFTを有する液晶表示装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0029】また、下地パターンが最終的には、異方性エッチングにてパターニングされることから、例えば異方性エッチングを垂直モードとした場合、下地パターンが垂直方向にパターニングされ、従って、下地パターンの微細加工ができ、線幅の縮小化を図ることが可能となる。

【0030】

【実施例】以下、本発明に係る半導体装置を、アクティブマトリクス表示方式における液晶表示装置の液晶用駆動スイッチとして使用されるTFT(薄膜トランジスタ)と信号蓄積に用いられる信号蓄積キャパシタに適用した実施例(以下、単に実施例に係る半導体装置と記す)を図1～図5を参照しながら説明する。

【0031】この実施例に係る半導体装置は、図1に示

すように、石英基板1上に1層目の多結晶シリコン層による活性層2（TFTのソース領域3、ドレイン領域4及びチャネル領域5並びに信号蓄積キャパシタの一方の電極6となる領域）が形成され、この活性層2上に薄い例えば熱酸化あるいはCVD法による SiO_2 、膜7を介して2層目の多結晶シリコン層によるゲート電極8及び信号蓄積キャパシタの他方の電極9が形成されて構成されている。

【0032】上記構成において、ゲート電極9と活性層2におけるソース領域3、ドレイン領域4及びチャネル領域5にて液晶駆動用のTFTが構成され、活性層2における一方の電極6及び2層目の多結晶シリコン層による他方の電極8並びにこれら電極6及び8間に介在する絶縁膜7にて信号蓄積キャパシタCsが構成される。

【0033】また、各電極8及び9上には、上層に形成される信号線11との絶縁と保護を目的とした例えば SiO_2 等からなる1層目の層間絶縁膜10が形成され、この層間絶縁膜10上に配線材料である例えばAl層による信号線11a及び接地線11bが形成されている。

【0034】上記信号線11上には、例えば SiO_2 等からなる2層目の層間絶縁膜12が形成され、この層間絶縁膜12上にTFTや信号蓄積キャパシタCsの特性向上を目的としたプラズマCVD法によるSiN膜（以下、P-SiN膜と記す）13が形成され、このP-SiN膜13上に平坦化を目的とした例えばSOG等からなる平坦化膜14が形成され、この平坦化膜14上に表示用としての例えばITO膜からなる透明電極15が形成されている。なお、図1の例は、透明電極15に対するパターンニングを行なう前の状態を示すものである。

【0035】そして、本実施例に係る半導体装置においては、2層目の多結晶シリコン層によるゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9の各上部における角部が面取りされて構成されている。

【0036】このことから、上記ゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9上に形成される1層目の層間絶縁膜10、特に各電極8及び9の段差部に対応する部分がなだらかとなって、上記層間絶縁膜10の形成後において、ゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9の段差が小さくなり、しかも、該層間絶縁膜10のステップカバレッジ（段差被覆性）が良好となる。

【0037】その結果、ゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9上に形成された層間絶縁膜10上に形成されるAl層による信号線11a及び接地線11bの断切れが回避され、液晶駆動用TFTを有する液晶表示装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0038】次に、上記実施例に係る半導体装置の製造方法について図2～図5の工程図を参照しながら説明する。なお、図1と対応する部分については同符号を記

す。

【0039】まず、図2Aに示すように、石英基板1上に、厚み約800Åの1層目の多結晶シリコン層を例えば減圧CVD法にて形成する。その後、シリコン（Si）を注入エネルギー約30keV、注入量 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 及び注入エネルギー50keV、注入量 $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ にて多結晶シリコン層に打ち込んだ後、温度620℃にて固相成長させることによって、結晶性の良好な1層目の多結晶シリコン層を得る。その後、上記1層目の多結晶シリコン層をパターンニングして活性層2を形成する。

【0040】次に、図2Bに示すように、熱酸化を施して、活性層2の表面に厚み約800Åの熱酸化膜7を形成する。即ち、熱酸化膜7によるTFTのゲート絶縁膜7と信号蓄積キャパシタCsの絶縁膜7を形成する。

【0041】次に、図2Cに示すように、上記活性層2中、信号蓄積キャパシタCsとなる部分に対応する箇所に開口を有するフォトリソトによるマスク（以下、単にレジストマスクと記す）21を形成した後、該レジストマスク21の開口を通じて活性層2内にn形の不純物、例えば砒素（As）を注入エネルギー約30keV、注入量 $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ にてイオン注入して信号蓄積キャパシタCsの一方の電極6を形成する。

【0042】次に、図2Dに示すように、上記レジストマスク21を除去した後、全面に厚み約3500Åの2層目の多結晶シリコン層22を減圧CVD法にて形成する。その後、2層目の多結晶シリコン層22上にPSG（リン・シリケート・ガラス）23を形成した後（二点鎖線で示す）、熱処理を施して、PSG23からのリン（P）の拡散により、下層の多結晶シリコン層22を低抵抗化（導電化）させる。

【0043】次に、図3Aに示すように、上記PSG23を除去した後、2層目の多結晶シリコン層22上にレジストマスク24を形成し、その後、該マスク24の窓24aから露出する下層の多結晶シリコン層22をその厚み方向途中まで、例えば多結晶シリコン層の厚みの例えば1/3ほど等方性エッチングにて除去する。この等方性エッチングとしては、例えば、 CF_4 ガスと O_2 ガスとの混合ガス（混合比 $\text{CF}_4 : \text{O}_2 = 95 : 5$ ）によるプラズマエッチング処理を用いることができる。

【0044】この等方性エッチングの特性により、多結晶シリコン層22へのサイドエッチングが進み、このエッチング加工後の残存する多結晶シリコン層22は、エッチング段差部の下部が広がった断面ほぼ台形状にパターンニングされ、全体としてなだらかな形状となる。なお、多結晶シリコン層22をその厚み方向途中までエッチングする場合、例えば時間制御にて行なうことができる。

【0045】次に、図3Bに示すように、上記レジストマスク24をそのままにして、該レジストマスク24の

窓24aから露出する残りの多結晶シリコン層22を今度は異方性エッチングにて除去する。この異方性エッチングとしては、例えばHBrガスとCl₂ガスの混合ガスによる垂直モードのRIE（反応性イオンエッチング）を用いることができる。この異方性エッチングにより、多結晶シリコン層22の段差形状は、エッチング方向に沿ったものとなる。本実施例では垂直モードのRIEによるため、段差の角度も垂直となる。しかも、上記等方性エッチングの場合と異なり、多結晶シリコン層22に対するサイドエッチング現象は発生せず、多結晶シリコン層22は、レジストマスク24のパターンに沿って忠実にパターニングされる。

【0046】上記等方性エッチング及び異方性エッチングによって、図3Cに示すように、2層目の多結晶シリコン層22によるTFTのゲート電極8と信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9が完成する。これら各電極8及び9の上部の角部aは、上記等方性エッチングによるサイドエッチングによって面取りされた形状となっている。

【0047】次に、図3Dに示すように、上記ゲート電極8をマスクとして、活性層2内にLDD（lightly doped drain）形成用の不純物、例えば砒素（As）を注入エネルギー約160keV、注入量 $1 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2}$ にてイオン注入することにより、活性層2内にLDD領域25を形成する。なお、上記活性層2中、ゲート電極8下の領域はTFTのチャネル領域5を構成する。

【0048】次に、図4Aに示すように、ゲート電極8を所定の厚みで被覆するレジストマスク26を形成した後、該レジストマスク26をマスクとして活性層2内にnチャネル形成用の不純物、例えば砒素（As）を注入エネルギー約140keV、注入量 $2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ にてイオン注入することにより、活性層2内にn形のソース領域3及びドレイン領域4を形成する。

【0049】次に、図4Bに示すように、上記レジストマスク26を除去した後、例えばPSGからなる厚み約2000Åの層間絶縁膜10を減圧CVD法にて形成する。この場合、各電極8及び9の上部の角部aが面取りされたかたちとなっているため、層間絶縁膜10の特に各電極8及び9の段差部に対応する部分がなだらかとなつて、該層間絶縁膜10の形成後において、各電極8及び9の段差が小さくなり、しかも、層間絶縁膜10のステップカバレッジ（段差被覆性）が良好となる。

【0050】その後、図示しないが、層間絶縁膜10における信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9及びTFTのソース領域3に対応する箇所にコンタクトホールを形成する。この場合、例えばHF液とNH₄F液の混合液によるウェットエッチングにて形成する。

【0051】次に、図4Cに示すように、全面に配線材料である例えば厚み約1000ÅのAl層を例えばスパッタリングにより被着形成した後、該Al層をパターニ

ングして、Al層による信号線11a及び接地線11bを形成する。この場合、下層の層間絶縁膜10の段差が各電極8及び9の角部aにおける面取り形状によって小さくなっているため、信号線11a及び接地線11bにおける各電極8及び9の段差部での断線は生じない。

【0052】次に、図5Aに示すように、全面に例えばSiO₂等からなる厚み約2000Åの2層目の層間絶縁膜12を形成する。その後、全面にTFT及び信号蓄積キャパシタCsの特性向上のためのSiN膜13をプラズマCVD法にて形成する。このプラズマCVD法によるSiN膜（P-SiN膜）13は、その機械的強度が高いため、下層のTFT及び信号蓄積キャパシタCsをキズから守ることができると共に、TFT及び信号蓄積キャパシタCsへの水分の侵入を防ぐことができる。また、このP-SiN膜13は水素（H₂）を多く含むため、該P-SiN膜13からの水素（H₂）が例えばTFT側に供給されることにより、活性層2の界面準位が十分に低減され、各素子（TFT及びCs）の特性の向上につながる。

【0053】そして、図5Bに示すように、表面の凹凸を平坦化する目的で全面に例えばSOG等による平坦化膜14を形成した後、全面に表示用としての例えばITO膜を例えばスパッタリングにて被着形成した後、該ITO膜をパターニングして液晶表示用の透明電極15を形成する。

【0054】その後の工程は、図示を省略するが、上記石英基板1と別の石英基板（一主面に対向電極が形成されている）をそれぞれ透明電極15と対向電極とが向かい合うように対向させ、かつスペーサを介して封着し、更に石英基板1と上記別の石英基板間に液晶層を注入した後、その注入口を封止して液晶表示装置を得る。

【0055】上記実施例に係る半導体装置の製造方法によれば、各電極8及び9を構成する2層目の多結晶シリコン層22を形成した後、該多結晶シリコン層22の上部を等方性エッチングにて選択的に除去し、その後、残りの多結晶シリコン層22を異方性エッチングにて選択的に除去して該多結晶シリコン層22によるTFTのゲート電極8及び信号蓄積キャパシタCsの他方の電極9を形成するようにしたので、多結晶シリコン層22による各電極8及び9は、最初の等方性エッチングによって、そのエッチング段差がなめらかとされているため、異方性エッチング後の各電極8及び9の角部aが面取りされたかたちとなる。

【0056】従って、各電極8及び9上に形成される層間絶縁膜10の特に各電極8及び9の段差部に対応する部分がなだらかとなつて、該層間絶縁膜10の形成後において、該各電極8及び9の段差が小さくなり、しかも、上記層間絶縁膜10のステップカバレッジ（段差被覆性）が良好となる。

【0057】その結果、各電極8及び9上に形成された

層間絶縁膜10上に形成されるA1層による信号線11a及び接地線11bの断切れが回避され、各電極8及び9上に積層膜が形成された半導体装置、この例では液晶駆動用TFTと信号蓄積キャパシタCsを有する液晶表示装置の歩留まりを向上させることが可能となる。

【0058】また、各電極8及び9が最終的には、垂直モードのRIEにてパターニングされることから、各電極8及び9が垂直方向にパターニングされ、従って、各電極8及び9の微細加工ができ、各電極8及び9の線幅の縮小化を図ることが可能となる。

【0059】上記実施例においては、液晶駆動用TFTと信号蓄積キャパシタCsを有する液晶表示装置に適用した例を示したが、その他、例えば多結晶シリコン層や高融点金属によるシリサイド層並びに高融点金属によるポリサイド層による配線層を下地パターンとし、この下地パターン上に層間絶縁膜を介してA1層や他の配線層が形成されたものであれば、すべての半導体装置において適用可能である。

【0060】

【発明の効果】上述のように、本発明に係る半導体装置によれば、下地パターンを含む2層以上の積層膜の少なくとも上記下地パターンの角部を面取りするようにしたので、上記下地パターンの上面に形成される配線層の断線を防止することができる。

【0061】また、本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、下地パターンを含む2層以上の積層膜を有する半導体装置の製造方法において、上記下地パターンとなる膜を形成する工程と、上記膜の上部を等方性エッチングにて選択的に除去する工程と、上記膜を異方性エッチングにて選択的に除去して上記下地パターンを形成する工程とを有するようにしたので、上記下地パターンの微細加工が可能で、かつその上面に形成される配線層の断線を防止ことができ、半導体装置の歩留まりの向上を図ることができる。

【図1】本発明に係る半導体装置を、アクティブマトリクス表示方式における液晶表示装置の液晶用駆動スイッチとして使用されるTFT（薄膜トランジスタ）と信号蓄積に用いられる信号蓄積キャパシタに適用した実施例（以下、単に実施例に係る半導体装置と記す）の構成を示す断面図である。

【図2】本実施例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その1）である。

【図3】本実施例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その2）である。

【図4】本実施例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その3）である。

【図5】本実施例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その4）である。

【図6】従来例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その1）である。

【図7】従来例に係る半導体装置の製造方法を示す工程図（その2）である。

【図8】等方性エッチングと異方性エッチングの違いを説明するための断面図である。

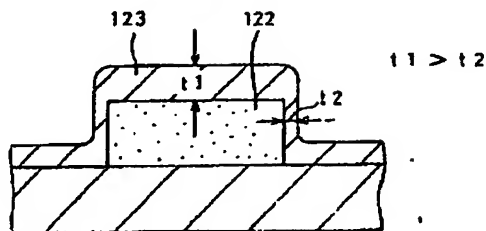
【図9】CVD法による膜の成膜特性、特に膜厚特性を説明するための断面図である。

【符号の説明】

- 1 石英基板
- 2 活性層
- 3 ソース領域
- 4 ドレイン領域
- 5 チャネル領域
- 6 信号蓄積キャパシタCsの一方の電極
- 7 ゲート絶縁膜
- 8 TFTのゲート電極
- 9 信号蓄積キャパシタCsの他方の電極
- 10, 12 層間絶縁膜
- 11a, 11b 信号線, 接地線

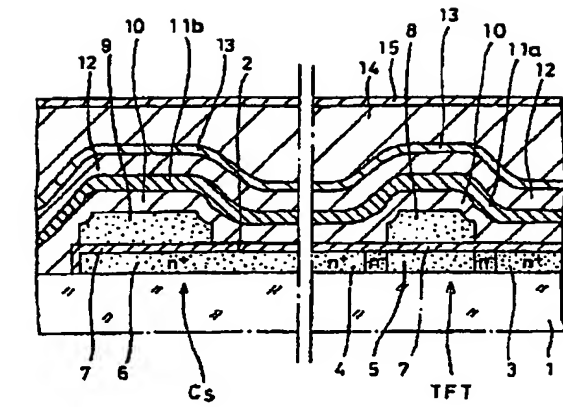
【図面の簡単な説明】

【図9】



CVD法による膜の成膜特性(膜厚特性)を示す断面図

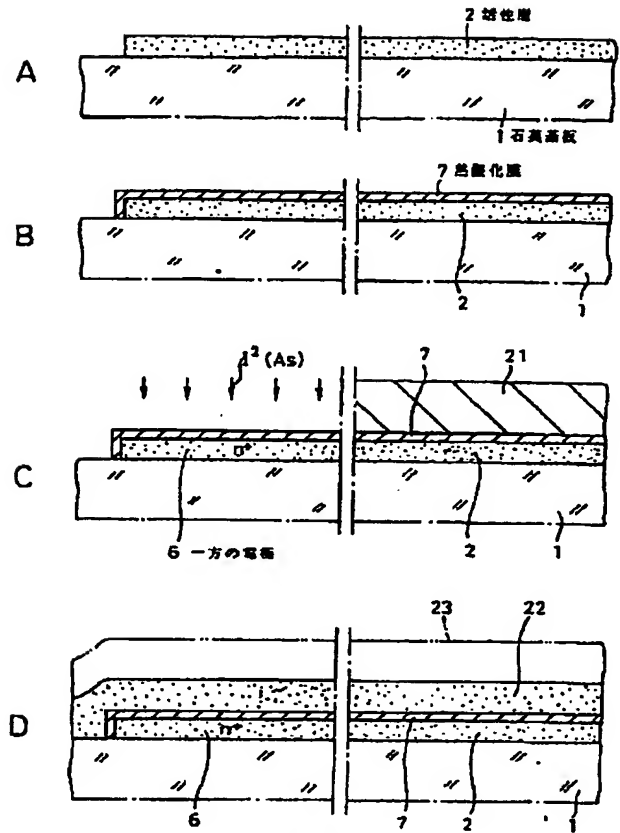
【図1】



- 1...石英基板
2...活性層
3...ソース領域
4...ドレイン領域
6...C₆₀の一方の電極
7...ゲート絶縁膜
8...ゲート電極
9...C₆₀の他方の電極
10,12...層間絶縁膜
11a,11b...接触孔、接続部

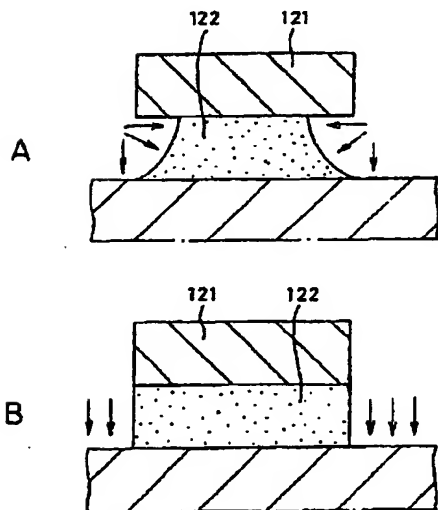
本実施例の構成を示す断面図

【図2】



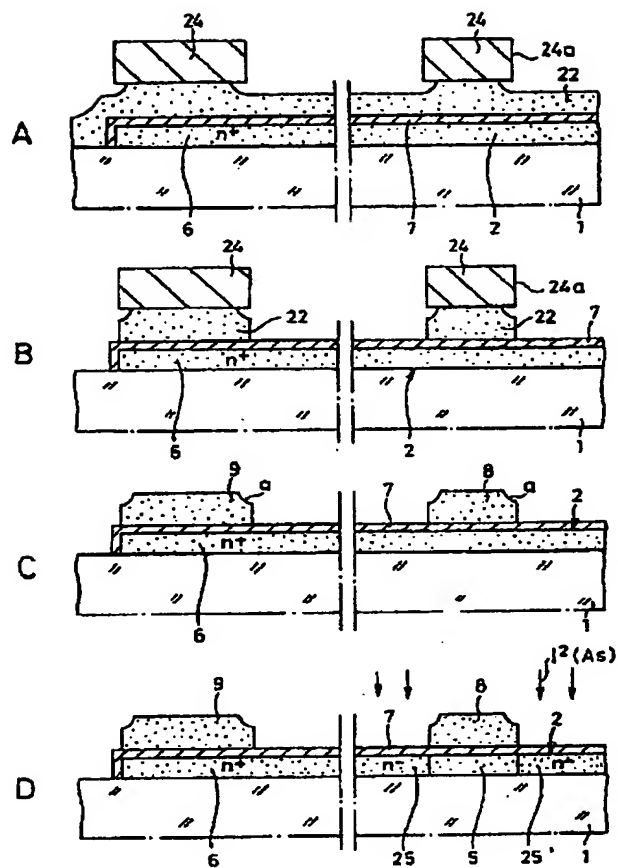
本実施例の製造工程図(その1)

【図8】



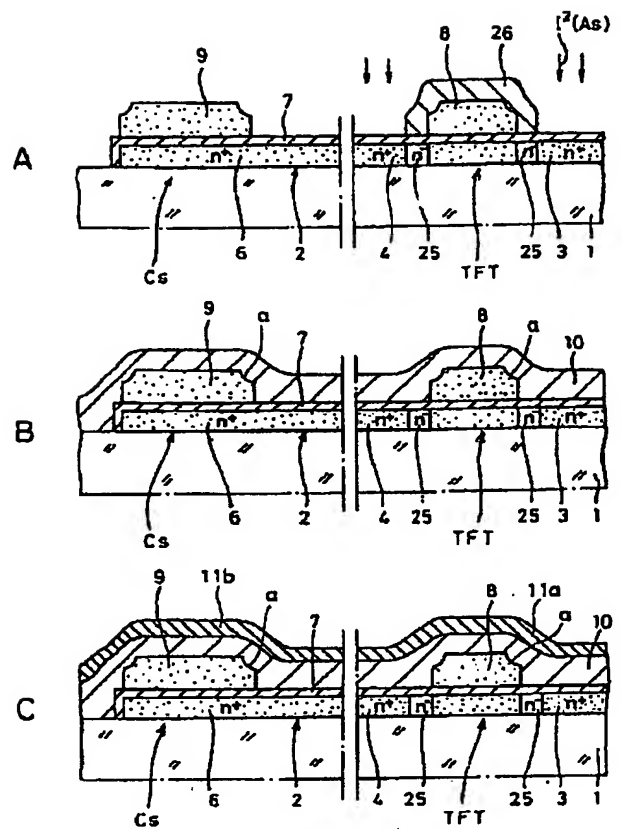
等方性エッチングと
異方性エッチングの違いを示す断面図

【図3】



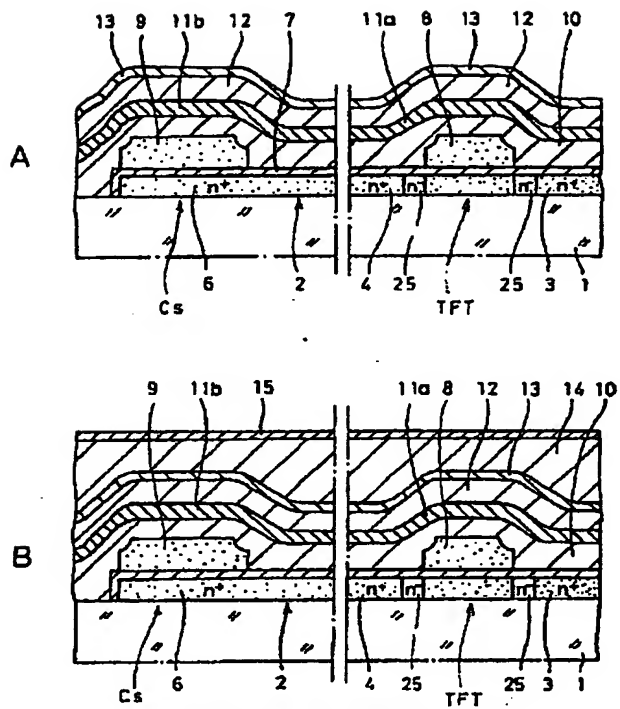
本実施例の製造工程図(その2)

【図4】



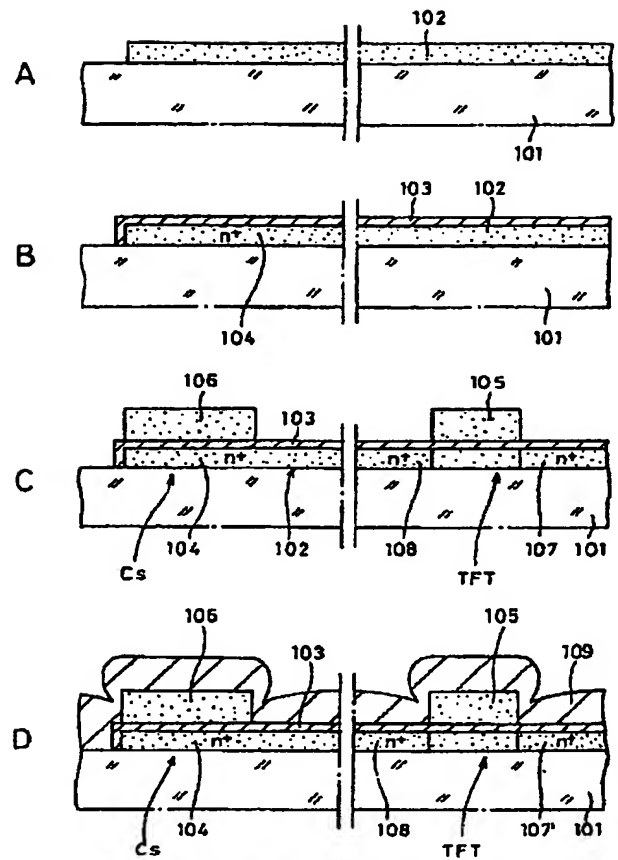
本実施例の製造工程図(その3)

【図5】



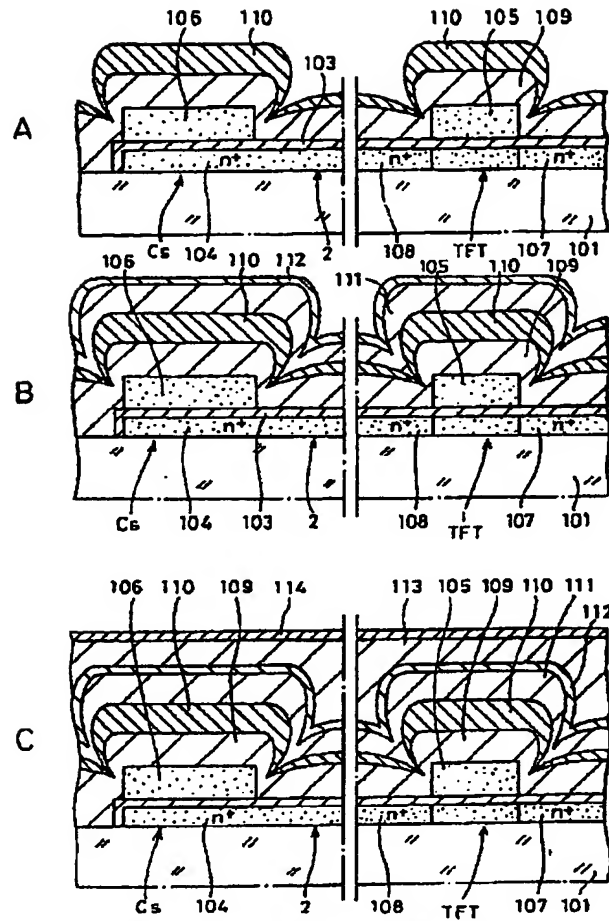
本実施例の製造工程図(その4)

【図6】



従来例の製造工程図(その1)

【図7】



従来例の製造工程図(その2)